

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08071427

(43) Date of publication of application: 19.03.1996

(51) Int.CI.

B01J 29/40 B01D 53/94

(21) Application number: 06195255

(22) Date of filing: 19.08.1994

(71) Applicant:

(72) Inventor:

HONDA MOTOR CO LTD FUJISAWA YOSHIKAZU TERADA KAZUHIDE SATO NAOHIRO NAKA TAKAHIRO FUKUDA KAORU ENDO TETSUO

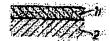
(30) Priority

Priority number: 06145949 Priority date: 28.06.1994 Priority country: JP

(54) CATALYST FOR PURIFICATION OF EXHAUST GAS

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a catalyst having superior high-temp, durability. CONSTITUTION: A catalyst 11 made of a mixture of a crystalline aluminosilicate with a catalytic element is carried on a honeycomb body 2. The crystalline aluminosilicate has an irregular crystal structure formed by lacking part of the constituent elements of a crystalline aluminosilicate having a regular crystal structure and the single lattice volume (V1) of the irregular crystal structure calculated from the crystal lattice constant by an X-dry diffraction method is made smaller than the single lattice volume (V1) of the regular crystal structure calculated from the crystal lattice constant by an X-ray diffraction method (V1<V2). The crystalline aluminosilicate of the catalyst 11 withstands 1,000° C and has function to adsorb hydrocarbons at low temp, as well as superior heat resistance. The catalytic element consists of Al2O3 particles and Pd carried on the particles carried on the particles.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平8-71427

(43)公開日 平成8年(1996)3月19日

(51) Int. C1. 6

識別記号 广内整理番号

技術表示箇所

B 0 1 J 29/40

ZAB A

B 0 1 D 53/94

B01D 53/36 103 Z

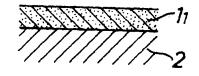
審査請求 有 請求項の数7 OL (全10頁) (21)出願番号 特願平6-195255 (71) 出願人 000005326 本田技研工業株式会社 (22)出顧日 平成6年(1994)8月19日 東京都港区南青山二丁目1番1号 (72)発明者 藤澤 義和 (31)優先権主張番号 特願平6-145949 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 (32)優先日 平6 (1994) 6月28日 本田技術研究所内 (33)優先権主張国 日本 (JP) (72) 発明者 寺田 一秀 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 本田技術研究所内 (72)発明者 佐藤 尚宏 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社 本田技術研究所内 (74)代理人 弁理士 落合 健 (外1名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】排気ガス浄化用触媒

(57)【要約】

【目的】 優れた高温耐久性を有する排気ガス浄化用触 媒を提供する。

【構成】 触媒 1, は、結晶性アルミノケイ酸塩と触媒素子との混合物よりなり、ハニカム体 2 に担持される。結晶性アルミノケイ酸塩は、正則結晶構造を備えた結晶性アルミノケイ酸塩における構成元素の一部が欠如した変則結晶構造を有すると共に、その変則結晶構造における X 線回折法による結晶格子定数から求められた単一格子体積 V_1 を、正則結晶構造における X 線回折法による結晶格子定数から求められた単一格子体積 V_2 よりも小(V_1 < V_2)に設定される。このような結晶性アルミノケイ酸塩は、その耐熱温度が 1000であって優れた耐熱性を有すると共に低温のHCを吸着する機能を有する。触媒素子は A_120 の A_2 を A_3 で A_4 を A_4 の A_4 を A_4 を A_4 の A_4 を A_4 を A_4 の A_4 を A_4 を A_4 を A_4 の A_4 を A_4 を



【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶性アルミノケイ酸塩と触媒素子との混合物より構成され、前記結晶性アルミノケイ酸塩における構成元素の一部が欠如した変則結晶構造を有すると共に、その変則結晶構造におけるX線回折法による結晶格子定数から求められた単一格子体積V1を、前記正則結晶構造におけるX線回折法による結晶格子定数から求められた単一格子体積V2よりも小(V1<V2)に設定され、前記触媒素子は、セラミックス製担体と、その担体に担持された触媒用金属および触媒用金属酸化物の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金属酸化物の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金属酸化物の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金属酸化物の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金属に関期表第1b族、周期表第VIIa族、鉄族および白金族の少なくとも1つの族から選択される少なくとも一種の金属であることを特徴とする排気ガス浄化用触媒。

【請求項2】 結晶性アルミノケイ酸塩よりなる少なく とも1つの層と、触媒素子よりなる少なくとも1つの層 とから多層構造に構成され、前記結晶性アルミノケイ酸 塩は、正則結晶構造を備えた結晶性アルミノケイ酸塩に おける構成元素の一部が欠如した変則結晶構造を有する と共に、その変則結晶構造におけるX線回折法による結 晶格子定数から求められた単一格子体積V」を、前記正 則結晶構造におけるX線回折法による結晶格子定数から 求められた単一格子体積V2よりも小(V1 < V2)に 設定され、前記触媒素子は、セラミックス製担体と、そ の担体に担持された触媒用金属および触媒用金属酸化物 の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金 属酸化物を構成する金属は周期表第 I b 族、周期表第 V IIa族、鉄族および白金族の少なくとも1つの族から選 択される少なくとも一種の金属であることを特徴とする 排気ガス浄化用触媒。

【請求項3】 上層が前記触媒素子よりなり、下層が前記結晶性アルミノケイ酸塩よりなる、請求項2記載の排気ガス浄化用触媒。

【請求項4】 上層が前記結晶性アルミノケイ酸塩よりなり、下層が前記触媒素子よりなる、請求項2記載の排気ガス浄化用触媒。

【請求項5】 前記変則結晶構造における前記単一格子 体積V₁がV₁≤5373Å³である、請求項1,2, 3または4記載の排気ガス浄化用触媒。

【請求項6】 アルカリ金属から選択される一種以上の金属またはアルカリ土類金属から選択される一種以上の金属の少なくとも一方の金属を含有し、その金属の含有率 C_1 が $C_1 \le 450 ppm$ である、請求項1, 2, 3, 4 または5記載の排気ガス浄化用触媒。

【請求項7】 前記触媒素子は微細粒状をなし、その粒径は0.05μm以上、50μm以下である、請求項1,2,3,4,5または6記載の排気ガス浄化用触 値

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は排気ガス浄化用触媒、特に、結晶性アルミノケイ酸塩と触媒素子とより構成される触媒に関する。

2

[0002]

【従来の技術】従来、エンジン始動直後の低温排気ガス中に存するHCの浄化率向上を狙って、排気系の排気ガス浄化用触媒よりも上流側に、ゼオライトを有するHC 10 用吸着器を配設した排気ガス浄化装置が知られている(特開平2-75327号公報参照)。また酸素過剰状態にある希薄混合気の燃焼に伴うNOxの浄化率向上を狙って、Cu等の金属をゼオライトにイオン交換法により担持させたゼオライト触媒も公知である(特開昭63-283727号公報参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】エンジンにおける排気ガス浄化用触媒の構成要素には900~1000℃の耐熱性が要求されるが、従来の装置および触媒におけるゼオライトはその耐熱温度が700℃程度であるため、吸着器および触媒の高温耐久性が乏しく、短時間のうちに性能劣化を招く、という問題があった。また従来の装置は、排気ガス浄化用触媒と吸着器とを必要とするので、装置の構成が煩雑化する、といった問題もある。

【0004】本発明は前記に鑑み、エンジン始動直後における低温排気ガス中のHCを吸着する機能を備え、また排気ガスによる触媒素子の温度上昇に伴い吸着したHCおよび新たなHCを直ちに浄化することができ、その上、酸素過剰状態にある希薄混合気の燃焼に伴うNOxをも浄化することのできる、高温耐久性に優れると共に構成の簡素化を達成された前記排気ガス浄化用触媒を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明に係る排気ガス浄化用触媒は、結晶性アルミノケイ酸塩と触媒素子との混合物より構成され、前記結晶性アルミノケイ酸塩における協力表の一部が欠如した変則結晶構造を有すると共に、をの変則結晶構造におけるX線回折法による結晶格子に数から求められた単一格子体積V1を、前記正則結晶格造におけるX線回折法による結晶格子定数から求められた単一格子体積V2よりも小(V1くV2)に設定され、前記触媒素子は、セラミックス製担体と、その担体に担持された触媒用金属および触媒用金属酸化物の少なくとも一方とよりなり、前記触媒用金属および金属酸化物を構成する金属は周期表第Ib族、周期表第VIIa族、鉄族および白金族の少なくとも1つの族から選択される少なくとも一種の金属であることを特徴とする。

【0006】本発明に係る排気ガス浄化田帥雄は 谷具

[0007]

【作用】結晶性アルミノケイ酸塩に、前記のように変則的な結晶構造を具備させると、耐熱温度が900~10 00℃に上昇し、これを用いた触媒は優れた高温耐久性を発揮する。

【0008】また前記結晶性アルミノケイ酸塩は高活性 20 化されているので、エンジン始動直後における低温排気 ガス中のHCを高捕集率で吸着する機能を備えている。そして、排気ガスの温度上昇に伴い、吸着したHCを放 出するので、そのHCおよび新たなHCは、昇温した触 媒素子によって直ちに浄化される。その上、前記結晶性 アルミノケイ酸塩を用いた触媒は、酸素過剰状態にある 希薄混合気の燃焼に伴うNOxに対しても浄化能を発揮 する。

【0009】この場合、触媒用金属等を結晶性アルミノケイ酸塩に直接担持させると、その触媒用金属等の多くが微細孔内に存することになるため、微細孔内の活性化雰囲気中で触媒用金属等が焼結して触媒の熱劣化を招くおそれがあるが、前記のように触媒用金属等をセラミックス製担体に担持させて結晶性アルミノケイ酸塩と混合するか、またはそれと積層構造にすると、前記熱劣化の問題を回避することができる。

【0010】また結晶性アルミノケイ酸塩と触媒素子と は混合または積層状態で存在するので、従来装置に比べ て構成が簡素化されている。

[0011]

【実施例】図1は低活性なアルミノケイ酸塩としての低活性2SM-5ゼオライトが持つ正則2SM-5型結晶構造の一例を示す。この結晶構造においては、10個の酸素からなる酸素環に、Siならびに周期律表第IIIa族および/または第IIIb族に属する元素E(例えば、B、Al、Sc、Ga、Y、In等)が結合している。

【0012】このような結晶構造を有する低活性 ZSM -5 ゼオライトに活性化処理を施して元素 Eを除去すると、図2に示すように、酸素環の周囲に在るケイ素環が、元素 Eが欠如した空孔を埋めるべく収縮する。それ 50

に伴いSi-O-Si結合角が図1の α から β へと拡大し($\beta>\alpha$)、その結果酸素環も収縮する。

【0013】このような現象が発生することから、本発明における結晶性アルミノケイ酸塩である高活性 2SM -5 ゼオライトは変則 2SM -5 型結晶構造(図 2)を備え、また酸素環およびケイ素環の収縮に伴い、 X 線回折による格子定数 a, b, c の積 $a \times b \times c$ として求められた単一格子体積 V_1 が、正則 2SM -5 型結晶構造における同様の単一格子体積 V_2 に比べて縮小される(即ち、 V_1 < V_2)。

【0014】前記酸素環の収縮は、その環内部の表面エネルギを高めるので、活性化処理後の2SM-5ゼオライトは高活性化され、また耐熱性も向上する。

【0015】変則2SM-5型結晶構造における単一格子体積V、はV、 ≤ 5373 ųであることが望ましい。V、>5373ųになると、高活性2SM-5ゼオライトの活性が低下傾向となる。

【0016】低活性ZSM-5ゼオライトは、その合成原料に起因して、アルカリ金属から選択される一種以上の金属、例えばNa、K、またはアルカリ土類金属から選択される一種以上の金属、例えばCa、Mgの少なくとも一方の金属を含有している。高活性ZSM-5ゼオライトにおいては、活性向上のため、その金属の含有率 C_1 は $C_1 \le 450$ ppm であることが望ましい。

【0017】また低活性 ZSM-5 ゼオライトは、その耐熱性に悪影響を与える Fe、Cu、Ni または Cr の少なくとも一種である不純物を含有することがあり、この場合、その不純物の含有率 C_2 は、耐熱性向上のために $C_2 \le 200$ ppm であることが望ましい。

30 【0018】前記活性化処理としては、低活性 Z S M - 5ゼオライトに酸処理、スチーム処理または沸騰水処理の少なくとも一つの処理を施す、といった方法が採用される。この活性化処理中に N a 等のアルカリ金属、C a 等のアルカリ土類金属、F e 等の不純物を前記含有率 C 1, C 2 に収まるように除去することができる。またアルカリ金属、アルカリ土類金属の除去は水素との置換によるものであるから、高活性 Z S M - 5 ゼオライトの細孔内における吸着活性サイトが増加し、またその増加は細孔内全体に均一に生じるので、高活性 Z S M - 5 ゼオ ライトの吸着能が向上する。

【0019】酸処理としては、0.5~5NのHC1溶液を70~90℃に昇温し、そのHC1溶液中に低活性2SM-5ゼオライトを5~20時間浸漬する、といった方法が採用される。

【0020】また沸騰水処理としては、低活性2SM-5ゼオライトに含水処理を施し、その含水状態の低活性2SM-5ゼオライト周りの雰囲気温度を550~600℃まで昇温し、その高温雰囲気下に4時間程度保持する、といった方法が採用される。

【0021】さらにスチーム処理レーアは 低圧性マロ

M-5ゼオライトを、10%程度の水分を含む600~ 900℃の雰囲気下に10~20時間保持する、といっ た方法が採用される。

【0022】これら酸処理、沸騰水処理およびスチーム 処理は、単独または2以上を組合わせて適用され、また 必要に応じて繰返される。

【0023】次に具体例について説明する。

【0024】A. 高活性2SM-5ゼオライトについて 表1は、低活性2SM-5ゼオライトおよびそれから得 られた高活性2SM-5ゼオライトの例1~5に関する*10 【表1】

*結晶格子定数 a , b , c および単一格子体積 V , , V 2 をそれぞれ示し、また表2は、低活性2SM-5ゼオラ イトの例1~5に対する活性化処理条件を示し、さらに 表3は、低活性2SM-5ゼオライトおよび高活性2S M-5ゼオライトの例1~5におけるアルカリ金属Na の含有量C1、不純物Feの含有量C2 および耐熱温度 ならびに高活性 ZSM-5ゼオライトの例1~5におけ るSiO2/Al2O3 モル比をそれぞれ示す。

[0025]

Ħ	低活性2SM-5ゼオライト				高活性2SM-5ゼオライト					
	結晶格子定数 (人)			单一格子 体積V。	箱	单一格子				
	а	b	С	(A ²)	а	b	С	体積Vェ		
1	20.083	19.939	13.420	5374	20.072	19.936	13.423	5371		
2	20.087	19.944	13.420	5376	20.082	19.924	13.419	5369		
3	20.090	19,939	13.418	5375	20.072	19.936	13.423	5371		
.4	20.083	19.939	13.420	5374	20.079	19.934	13.413	5369		
5	20.087	19.944	13.420	5376	20.077	19.930	13.418	5369		

[0026]

※ ※【表2】

<i>5</i> 94	活包	化処理
79	処 理 法	条 件
1	酸 処 選	90° 5N HC1 20h
2	酸 処 理	90°C, 5N HC1, 20h
3	段 処 理	90°, 5N HC1, 20h
4	1回日:酸処理	90°, 5N HC1, 20h
	2回目:スチーム処理	10%H: 0.600°, 20h
5	1回目:酸処理	90t, 5N HC1, 20h
	2回目:スチーム処理	10%H, O. 600%, 20h
	3回目: 酸処理	90%, 5N HC1, 20h

	低活性2SM-5ゼオライト			高活性 Z S M - 5 ゼオライト					
64	N a (ppm)	F e (ppm)	耐熱温度 (で)	Na (ppm)	Fe (ppm)	耐熱温度 (°C)	SiO:/A1:0: モル比		
1	3580	1651	725	1 1 3. 4	5 7	1000	4 4		
2	2685	1237	7 2 5	1 1 0. 5	5 3	1000	5 2		
3	3 1 0 1	875	7 2 5	403.2	9 5	1000	8 5		
4	3580	1651	725	1125	5 6	1000	5 2		
5	2685	1237	725	82.7	3 2	1000	6 3		

図3は、Si 固体NMR(核磁気共鳴)法で測定した、低活性および高活性ZSM-5 ゼオライトの例1 に関するSi 化学シフト、 δ (ppm)を示す。高活性ZSM-5 ゼオライトの例1 のSi 化学シフト、 δ 、は δ 、=-112、4 3 ppm であり、また低活性ZSM-5 ゼオライトの例1 のSi 化学シフト、 δ 2 は δ 2 =-112、31 である。

【0028】ここでジェイ、エム、トーマス(J. M. Thomas)の式、 α (または β)= $(-25.44-\delta)/0.5793$ から、低活性および高活性ZSM-5ゼオライトの例1におけるSi-O-Si 結合角 α および β を求めたところ、 $\alpha=149.96$ °、 $\beta=150.16$ °であり、したがって、 $\beta>\alpha$ であることが判明した。故に、両単一格子体積 V_1 , V_2 の間には V_1 < V_2 の関係が成立する。この場合、除去された元素 EはA1である。

【0029】低活性および高活性2SM-5ゼオライトの例1~5の耐熱温度測定は以下に述べる方法で行われた。先ず、各例1~5のBET比表面積、即ちイニシャルBET比表面積を測定し、次いで、各例1~5を10%の水分を含む空気雰囲気中で20時間昇温加熱し、その際、25℃毎に加熱後のBET比表面積を測定した。そして、加熱後のBET比表面積がイニシャルBET比表面積の95%を維持しているときの温度を各例1~5の耐熱温度とした。

【0030】このような方法で測定された高活性2SM -5ゼオライトの例1~5における耐熱温度は1000 ℃であり、一方、同様の方法で測定された低活性2SM -5ゼオライトの例1~5(ただし、例1と4および2と5は同じもの)における耐熱温度は725℃であって、275℃の向上が認められた。

【0031】B. 排気ガス浄化用触媒について 図4に示す単層構造の触媒1,は、微細粒状高活性ZS M-5ゼオライトと、微細粒状触媒素子とを混合したも ので、その触媒1,はハニカム体2に担持される 【0032】触媒素子は、微細粒状セラミックス製担体と、その担体に担持された触媒用金属および触媒用金属酸化物の少なくとも一方とよりなる。セラミックス製担体としては化学的に活性なγ-Al₂O₃、ZrO₂、
20 TiO₂、SiO₂、MgO、CeO₂等の微細粒が用いられる。また触媒用金属および触媒用金属酸化物における金属は、周期表第Ib族、周期表第VIIa族、鉄族および白金族の少なくとも一つの族から選択される少なくとも一種の金属が該当する。周期表第VIIa族にはMn、Te、Reが含まれ、また周期表第VIIa族にはMn、Te、Reが含まれ、さらに鉄族にはFe、Co、Niが含まれ、さらにまた白金族にはRu、Rh、Pd、Os、Ir、Ptが含まれる。必要に応じて、Ce、Ba、La、Y、Nd、Sm、Gd、Nb、Zr、Ni、Feおよびそれらの酸化物等の助触媒が併用される。

【0033】前記触媒1、の製造に当っては、先ず、例えば触媒用金属を溶解している溶液中にセラミックス製担体を投入し、その担体表面に触媒用金属を担持させて触媒素子を製造する。次いで、高活性2SM-5ゼオライトと触媒素子とを混合してスラリ状混合物を調製し、そのスラリ状混合物中にハニカム体2を浸漬し、引上げた後ハニカム体2に付着したスラリ状混合物を乾燥して触媒1、を得る。

40 【0034】図5に示す多層構造、図示例では二層構造の触媒12は、高活性2SM-5ゼオライトよりなる少なくとも1つの層、つまり下層31と、前記同様の触媒素子よりなる少なくとも1つの層、つまり上層32とから構成され、その触媒12はハニカム体2に担持される。

【0035】このような触媒12の製造に当っては、先ず、高活性2SM-5ゼオライトを含むスラリ状物を調製し、そのスラリ状物中にハニカム体2を浸漬し、引上げた後ハニカム体2に付着したスラリ状物を乾燥して下

50 展々 ケ形ポナス ゲハッ みキャー・ノ

スラリ状物にハニカム体2を浸漬し、引上げた後下層3 1 に付着したスラリ状物を乾燥して上層32を形成する。上層32を高活性2SM-5ゼオライトより構成し、下層31を触媒素子より構成する場合には、前記作業において、ハニカム体2の浸漬順序を前記と逆にすればよい。

【0036】前記触媒 1_1 , 1_2 において、触媒素子の粒径は、 0.05μ m以上、 50μ m以下である。粒径が 0.05μ m未満では、触媒素子の粒径が小さすぎるため排気ガスの流通性が悪化し、一方、 50μ mを超えるということは担体の粒径が大きくなることを意味するので、その担体の比表面積が小さくなって触媒用金属等の担持量が減少し、触媒活性が低下する。好ましくは、触媒素子の粒径は 0.1μ m以上、 25μ m以下であ

*る。

【0037】 [I] 高活性2SM-5ゼオライトを用いたHC浄化用触媒について

表4は、実施例1,2および比較例1~6の触媒の構成を示す。表中、ゼオライトは高活性2SM-5ゼオライトを、また低活性は低活性2SM-5ゼオライトをそれぞれ意味する。助触媒としてはCeO、BaO、ZrO2が用いられた。また実施例1,2および比較例1,3~6の触媒を担持するハニカム体としては、直径25mm、長さ60mmの円筒形をなし、300セル/in²のものが用いられた。

【0038】 【表4】

	高活性 Z S M-5ゼオ ライトの種 類	ハニカム体における 担持量(g/タットル)		独	A. 145 -				
触媒				担体	金属		5	WL 44 /	触媒素子 の 粒 径
		ゼオライト	独集素子	AlzOz	Pd Pt		Rh	助触導	[(µ m)
実施例1	₩ 1	90	35	15	10	-	-	10	0.5~15
実施例2	6 9 1	下層 90	上 期 35	15	10	-	-	10	0.5~15
比較例1	69 2	90	10		10	-		-	-
比較例2	例 2	180	250	115	_	1.5	0.3	8.2	0.5~20
比較例3	-	_	125	115	-	. 1.5	0.3	8.2	0.5~20
比較例4	-		125	105	10	-		10	0.5~15
比較例 5	低活性	90	35	15	10		-	10	0.5~15
比較例 6	低活性	下屬 90	上 遍 35	15	10	_		10	0.5~15

実施例1の触媒は、高活性2SM-5ゼオライトと触媒素子との混合物より単層構造に構成され、また実施例2の触媒は、高活性2SM-5ゼオライトよりなる下層と触媒素子よりなる上層とから二層構造に構成されている。比較例1の触媒は、高活性2SM-5ゼオライトに触媒用金属をイオン交換法により担持させて構成され、また比較例3,4の触媒は触媒素子のみから構成され、さらに比較例5の触媒は、低活性2SM-5ゼオライトと触媒素子との混合物より単層構造に構成され、さらにまた比較例6の触媒は、低活性2SM-5ゼオライトよりなる下層と触媒素子よりなる上層とから二層構造に構成されている。

【0039】比較例2の触媒は、第1ハニカム体に担持された高活性2SM-5ゼオライトと第2ハニカム体に担持された触媒素子とより構成され、第1ハニカム体は排気系の上流側に、また第2ハニカム体間の間隔は5mに設されぞれ配設される。両ハニカム体間の間隔は5mに設

定された。それらハニカム体は、長さが30mmであることを除いて、前記のものと同一構造を有する。

【0040】実施例1および比較例1~4の触媒について、それらの初期性能を調べるため、次のようなHC浄化テストを行い、各触媒によるHC浄化率を測定したところ、図6の結果を得た。

【0041】前記テストは、組成が、0.5体積% O₂、400ppm HC (C₃ H₆)、500ppm NO、5000ppm CO、14体積%CO₂、1700ppm H 2、10体積%H₂Oおよび残部N₂であるテスト用ガスを、各ハニカム体(比較例2では第1,第2ハニカム体)内に空間速度(S.V.)20000h⁻¹で流通させると共にテスト用ガスの温度を50~350℃まで昇温速度3~15℃/secで昇温させ、この間のHC浄化率を測定することによって行われた。

【0042】図6において、線aが実施例1の触媒に、また線h~cが比較例1、4の単純に

5

る。線 f はガス温度を示す。図 6 より、線 a で示す実施例 1 および線 b で示す比較例 1 の両触媒は、ガス温度の低い領域から高い領域に亘って高いHC浄化率を有することが判る。これは、ガス温度の低い領域では高活性 2 SM-5 ゼオライトが高捕集率で低温のHCを吸着する機能を発揮し、またガス温度の高い領域では触媒素子が高いHC浄化能を発揮することに起因する。

【0043】線cで示す比較例2の触媒の場合、ガス温度の低い領域ではHC净化率が高いが、ガス温度の高い領域では第2ハニカム体に担持された触媒素子の温度上昇が第1ハニカム体によって妨げられるためHC浄化率が低い。線d, eで示す比較例3, 4の触媒は、ガス温度の低い領域においてHC吸着能を持たないので、HC浄化率が低い。

【0044】次に、実施例1,2および比較例1,3~6の触媒をエンジンの排気系に配設して、900℃の高温下に20時間保持し、その後、各触媒の耐久テスト後の性能を調べるため、前記同様のHC浄化テストを行い、各触媒によるHC浄化率を測定したところ、図7の結果を得た。

【0045】図7における各線と各触媒との関係は表5の通りである。線fは前記同様にガス温度を示す。

[0046]

【表5】

線	独 媒
a ı	実施例 1
g ı	実施例 2
b ı	比較例 1
6 1	比較例 3
ď,	比較例 4
h,	比較例 5
k,	比較例 6

図7より、線 a_1 , g_1 で示す実施例1, 2の触媒は線 b_1 , e_1 , d_1 , h_1 , k_1 で示す比較例1, $3\sim 6$ の触媒に比べて耐久テスト後のHC浄化率が高い。これ

は、実施例1,2における高活性2SM-5ゼオライトの耐熱性が良好であることから、両触媒が優れた高温耐久性を有することに他ならない。特に、線g1で示す実施例2の二層構造触媒の方が、線a1で示す実施例1の単層構造触媒よりも高い触媒活性を備えている。

12

【0047】線b1で示す比較例1の触媒の場合、前記耐久テストにおいて高活性2SM-5ゼオライトが耐熱性を発揮するため、ガス温度の低い領域では高活性2SM-5ゼオライトのHC吸着能を得て高いHC浄化率を10 示すが、前記耐久テストにおいて触媒用金属であるPdの焼結が発生していることに起因して、ガス温度の高い領域ではHC浄化率が低い。線d1で示す比較例3の触媒の場合、もともと触媒用金属であるPt,Rhの担持量が少ない上に、前記耐久テストにより熱劣化しているため耐久テスト前に比べてHC浄化率が大幅に低下する。線e1で示す比較例4の触媒の場合、前記耐久テストによる熱劣化の程度が比較的小さいため、HC浄化率の低下は小幅である。線h1,k1で示す比較例5,6の触媒の場合、前記耐熱テストによって低活性2SM-20 5ゼオライトが熱劣化するため、HC浄化率が低い。

【0048】図8は、FTP LA-4モードにおけるエンジン(排気量2000cc)始動後の経過時間とHCの排出レベルとの関係を示す。図中、線m, a2, d2はエンジンから排出されるHC成分の変化を示し、線mが触媒を用いなかった場合に、線a2が前記耐久テスト後の実施例1の触媒を用いた場合に、線d2が前記耐久テスト後の比較例3の触媒を用いた場合にそれぞれ該当する。

【0049】図8から明らかなように、線a2で示すよ 30 うに実施例1の触媒を用いると、線d2で示す比較例3 の触媒を用いた場合に比べて、HCの排出レベルを50 %以上低減することができる。

【0050】 [II] 高活性 ZSM-5ゼオライトを用いたNOx 浄化用触媒について

表6は、実施例3~7および比較例7,8の触媒の構成を示す。表中、ゼオライトは、高活性2SM-5ゼオライトを意味し、また低活性は低活性2SM-5ゼオライトを意味する。各触媒を担持するハニカム体としては、前記同様に直径25mm、長さ60mmの円筒形をなし、34000セル/in²のものが用いられた。

[0051]

【表6】

	高活性 Z S M - 5 ゼオ ライトの種	ハニカム体における 担持量(g/タゥトム)		触媒素				
放媒				担体	金 属			触集素子の粒径
	類	ゼオライト	触媒案子	A1:0:	Cu	Co	Pt	(µm.)
実施例 3	6 1	90	18.5	15	3.5	-	-	0.5~20
実施例 4	例 1	90	19.5	15	-	4.5	-	0.5~20
実施例 5	例 1	90	18	15	-	-	3	0.5~20
実施例6	6 1	下層 90	上層 18	15	_	-	3	0.5~20
実施例?	<i>9</i> 91	上 周 18	下 層 90	15	-	-	3	0.5~20
比較例?	低活性	90	3.5	_	3.5	-	_	0.5~20
比較例8	低活性	90	18	15		-	3	0.5~20

実施例3~5の触媒は、高活性2SM-5ゼオライトと 触媒素子との混合物より単層構造に構成され、また実施 例6の触媒は、高活性2SM-5ゼオライトよりなる下 層と触媒素子よりなる上層とから二層構造に構成され、 さらに実施例7の触媒は、触媒素子よりなる下層と高活 性2SM-5ゼオライトよりなる上層とから二層構造に 構成されている。

【0052】比較例7の触媒は、低活性2SM-5ゼオライトに触媒用金属をイオン交換法により担持させて構成され、また比較例8の触媒は、低活性2SM-5ゼオライトと触媒素子との混合物より単層構造に構成されている。

【0053】実施例5~7および比較例7,8の触媒について、それらの初期性能を調べるため、次のような希 薄混合気の燃焼を想定したNOx浄化テストを行い、各 触媒におけるガス温度とNOx浄化率との関係を調べた ところ、図9の結果を得た。

【0054】前記テストは、組成が、10体積%O2、800ppm HC(C3 H6)、800ppm NO、0.1 体積%CO、10体積%CO2、500ppm H2、10体積%H2 Oおよび残部N2であるテスト用ガスを、各ハニカム体内に空間速度(S. V.) 20000h⁻¹で 40流通させると共にテスト用ガスの温度を25~400℃まで昇温速度10~40℃/minで昇温させ、この間のNOx浄化率を測定することによって行われた。

【0055】図9において、線n, o, uは実施例5, 6, 7の触媒にそれぞれ該当し、また線p, qは比較例7, 8の触媒にそれぞれ該当する。図9から明らかなように、各触媒は比較的良好な初期性能を有する。

【0056】次に実施例3~7および比較例7,8の触 また前記同様に、線o1, u1で示す実施 媒をエンジンの排気系に配設して、700℃の高温下に 層構造触媒は、線1,等で示す実施例3等 20時間保持し、その後、各触媒の耐久テスト後の性能 50 媒よりも高い軸伸を伸む停止でいる。

を調べるため、前記同様のNOx浄化テストを行い、各 20 触媒によるNOx浄化率を測定したところ、図10の結 果を得た。

【0057】図10における各線と各触媒との関係は表7の通りである。

[0058]

【表7】

線	触 媒
Γ,	実施例3
S 1	実施例4
n ı	実施例 5
0 1	実施例 6
u,	実施例7
рı	比較例7
q ı	比較例8

図10から明らかなように、線r1, s1, n1, o1, u1で示す実施例3~7の触媒は、線p1, q1で示す比較例7, 8の触媒に比べて耐久テスト後のNOx浄化率が高い。これは、実施例3~7における高活性2SM-5ゼオライトの耐熱性が良好であることから、各触媒が優れた高温耐久性を有することに他ならない。また前記同様に、線o1, u1で示す実施例3等の単層構造触媒は、線r1等で示す実施例3等の単層構造触媒よりも高い触ば平性を停止でいる。

例6,7の触媒活性は殆ど同じである。

【0059】なお、触媒は、高活性2SM-5ゼオライ トよりなる層と触媒素子よりなる層を、例えば交互に積 層する、というように、両層を2以上備えることもあ る。

[0060]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、エンジン 始動直後から高いHC浄化能を発揮し、また酸素過剰状 態にある希薄混合気の燃焼に伴うNOxに対する浄化能 も高く、さらに優れた高温耐久性を有すると共に構成の 簡素化を達成された排気ガス浄化用触媒を提供すること ができる。

【0061】請求項2記載の発明によれば、前記の場合 よりも高い触媒活性を有する排気ガス浄化用触媒を提供 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】正則2SM-5型結晶構造を示す説明図であ

【図2】変則2SM-5型結晶構造を示す説明図であ る。

【図3】高活性および低活性2SM-5ゼオライトに関

するSi化学シフトを示すグラフである。

【図4】 単層構造の触媒を示す断面図である。

【図5】 二層構造の触媒を示す断面図である。

【図6】各触媒の初期性能テストにおけるガス流通開始 後の経過時間とHC浄化率との関係を示すグラフであ る。

16

【図7】各触媒の耐久テスト後におけるガス流通開始後 の経過時間とHC浄化率との関係を示すグラフである。

【図8】FTP LA-4モードにおけるエンジン始動 10 後の経過時間とHCの排出レベルとの関係を示すグラフ である。

【図9】各触媒の初期性能テストにおけるガス温度とN Ox 浄化率との関係を示すグラフである。

【図10】各触媒の耐久テスト後におけるガス温度とN Ox浄化率との関係を示すグラフである。

ガス波瀾開始後の経過時間(sec)

【符号の説明】

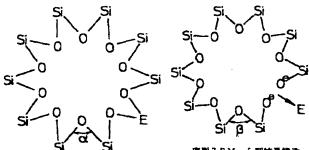
11, 12 触媒

2 ハニカム体

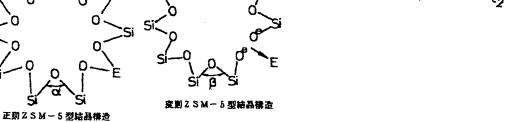
下層 3,

3 2 上層 20

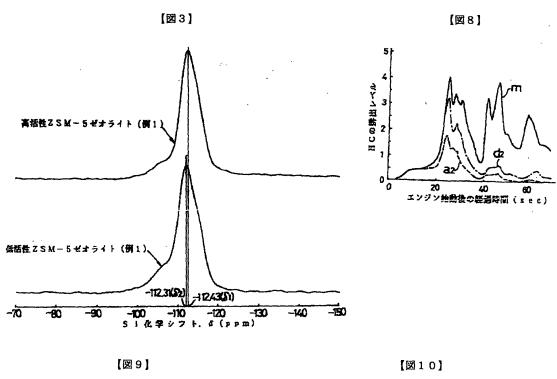
【図4】 【図5】 【図1】 【図2】

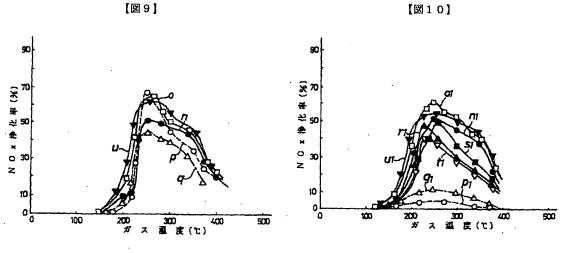


ガス流通開始後の経過時間(sec)



【図6】 【図7】 $\widehat{\mathbf{x}}$ ž H 井 **≈** 50 ₩ 50 £ Ŷ. U ပ 100





フロントページの続き

(72)発明者 中 貴弘 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内

(72)発明者 福田 薫 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内 (72)発明者 遠藤 妊維

(72)発明者 遠藤 哲雄 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内